

GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器, 18 - 32 GHz

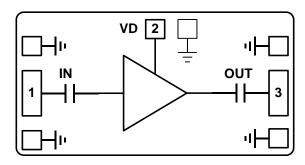
主要特点

工作频率: 18 - 32 GHz 噪声系数: 2.4 dB

增益: 21 dB P1dB: +10 dBm

自偏置供电: +3 V @ 52 mA 输入/输出: 50 Ohm 匹配 芯片尺寸: 2.3 × 1.3 × 0.1 mm³

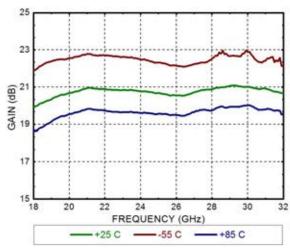
功能框图



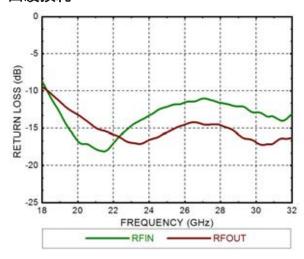
性能指标(T_A = +25°C, VDD = +3 V,IDD = 52 mA)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		18 - 32		GHz
增益		21		dB
增益平坦度		±0.5		dB
输入回波损耗		10		dB
输出回波损耗		10		dB
输出功率 1dB 压缩点		10		dBm
饱和功率		13		dBm
输出 IP3		19		dBm
噪声系数		2.4		dB
工作电流	33	52	71	mA

增益



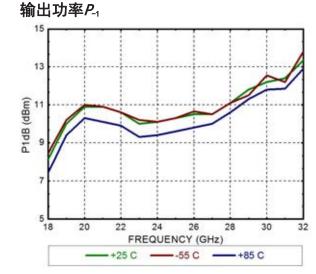
回波损耗



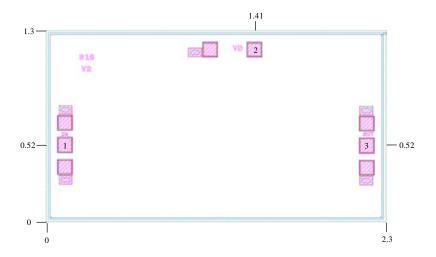


GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器,18 - 32 GHz

噪声系数 NOISE FIGURE (dB) 20 26 30 FREQUENCY (GHz)



物理参数



焊盘描述

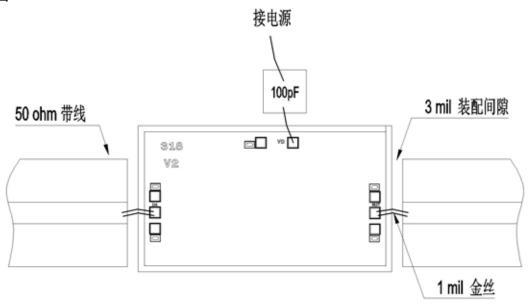
焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合,并匹配至 50 Ohm
2	VD	该焊盘提供放大器的电源电压,需要外接 100pF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合,并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



V01.2018

GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器, 18 - 32 GHz

装配图



注意事项

- 1. 芯片厚度为 100 um
- 2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 um²
- 3. 键合焊盘金属化: 金
- 4. 芯片背面镀金
- 5. 芯片背面接地
- 6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

- 1. 电源电压: +5 V
- 2. 射频输入功率: +16 dBm
- 3. 储存温度: -65~+175°C
- 4. 工作温度: -55~+85°C